

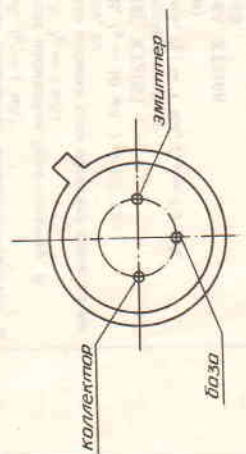


ТРАНЗИСТОРЫ
КТ316А, КТ316Б, КТ316В,
КТ316Г, КТ316Д

ЭТИКЕТКА

Кремниевые планарно-эпитаксиальные $n-p-n$ -транзисторы КТ316А, КТ316Б, КТ316В, КТ316Г, КТ316Д в металлическом корпусе, предназначенные для работы в усилительных схемах устройств широкого применения.

Схема расположения выводов



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при $t = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения, тип транзистора	Норма	
	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока ($I_K = 0, I_3 = 10\text{ мА}$)		
КТ316А	20	60
КТ316Б, КТ316В	40	120
КТ316Г	20	100
КТ316Д	60	300
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{КБ} = 10\text{ В}$)	—	0,5
Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{ЭБ} = 4\text{ В}$)	—	1
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ} = 5\text{ В}, I_3 = 10\text{ мА}, f = 10^6\text{ Гц}$)		
КТ316А, КТ316Г, КТ316Д	6	—
КТ316Б, КТ316В	8	—
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер, В ($I_K = 10\text{ мА}, I_3 = 1\text{ мА}$)	—	0,4
Напряжение насыщения база—эмиттер, В ($I_K = 10\text{ мА}, I_3 = 1\text{ мА}$)	—	1,1
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте, нс ($U_{КБ} = 5\text{ В}, I_3 = 10\text{ мА}, f = 10^7\text{ Гц}$)	—	150
Время рассасывания, нс ($I_{Кн} = 10\text{ мА}, I_{Б1} = 1\text{ мА}, I_{Б2} = 1,2\text{ мА}, R_K = 70\text{ Ом}$)	—	10
КТ316А, КТ316Б	—	15
КТ316В	5	—
Граничное напряжение, В ($I_K = 1\text{ мА}$)	—	3
Емкость коллекторного перехода, пФ ($U_{КБ} = 5\text{ В}, f = 10^7\text{ Гц}$)	—	2,5
Емкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{ЭБ} = 0, f = 10^7\text{ Гц}$)	—	—

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ

золото — ~~10,8023~~ г, **0,2831**

в том числе

золото — ~~0,8484~~ 10^{-4} г/мм на 3 выводах длиной 23 мм
каждого транзистора.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов КТ316А, КТ316Б, КТ316В, КТ316Г, КТ316Д соответствуют техническим условиям СБ0.336.030 ТУ.

Место для простановки
конкретного типа транзисторов,
находящегося в данной упаковке

КТ-316 А

СТК 721

06-93

Место для штампа

10